УДК 538.951, 531.7 РАСЅ 61.43.Fs, 62.25.+g, 68.60.Bs, 81.07.-b DOI: 10.24144/2415-8038.2017.41.58-67 В.В. Біланич¹, А.В. Бендак¹, В.Ю. Ізай¹, К.В. Скубенич¹, В.І. Феделеш¹, F. Lofaj², І.П. Студеняк¹, В.С. Біланич¹, В.М. Різак¹ ¹Ужгородський національний університет, 88000, Ужгород, вул. Волошина, 54 ²Institute of Materials Research of SAS, Kosice, Slovak Republic e-mail: vvbilanych@gmail.com

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУПЕРІОННИХ КРИСТАЛІВ ТА ПЛІВОК Cu₆PS₅Br(I) МЕТОДОМ МІКРО- ТА НАНОІНДЕНТУВАННЯ

Досліджено зміну твердості H та модуля Юнга E монокристалів та плівок $Cu_6PS_5Br(I)$ у залежності від глибини занурення індентора Берковича. Вимірювання H і Е проводили при температурі 295 К у режимі гармонічної модуляції лінійно зростаючого навантаження на індентор. Зміни числових значень Е і H досліджених монокристалів у залежності від глибини відбитку у нано- і мікрообластях проінтерпретовані у рамках моделі деформаційного градієнта. Виявлено зменшення мікротвердості плівок типу Cu_6PS_5BrI при зростанні вмісту міді, яке обумовлене наносепарацією з утворенням електропровідних кластерів та дендритів.

Ключові слова: нано- і мікроіндентування, суперіонні матеріали, Cu₆PS₅Br(I), дислокації, твердість, розмірний ефект індентування, модель пластичності градієнта напруженості.

Вступ

Завдяки високій іонній провідності кристали $Cu_6PS_5Br(I)$ представляють як практичний інтерес, зокрема, для твердотільної іоніки, так і науковий інтерес як матеріали з суперіонним та сегнетоеластичним фазовими переходами. [1-3]. При виготовленні нанокомпозитів та плівок на основі вказаних суперіонних кристалів важливою є інформація про їх фізичні параметри в субмікро- та нанооб'ємах і тонких шарах.

Відомо, що при зменшенні області зондування твердого тіла (<100 нм) його фізичні параметри будуть наближатися до гранично можливих теоретичних [4]. Ефективним методом вивчення таких явищ є мікро- та наноіндентування матеріалів під дією гармонічно модульованого навантаження [5].

Метою даної роботи було дослідження змін нанотвердості та модуля Юнга монокристалів $Cu_6PS_5Br(I)$ та плівок від глибини відбитку, а також змін твердості вказаних матеріалів з різним хімічним складом.

Методика експерименту

Для вимірювання нанотвердості були використані монокристали Cu₆PS₅Br та Си₆PS₅I, вирощені методами Бріджмена-Стокбаргера (Б-С) та газотранспортних реакцій (ГТР), а також тонкі плівки на основі сполуки Cu₆PS₅I. Плівки отримували методом нереактивного магнетронного розпилення. Для отримання плівок з різним вмістом міді, було використано систему, в якій скляна підкладка рухалася під час напилення по відношенню до двох нерухомих мішеней, в одній з яких була чиста мідь, в іншій – сполука Cu₆PS₅I. Таким чином, було отримано плівки товщиною d=1 мкм, співвідношення хімічних елементів у яких неперервно змінювалося у певному концентраційному діапазоні. Хімічний склад плівок було визначено за допомогою енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDX).

Вимірювання E і H даних суперіонних матеріалів проводили за допомогою наноіндентометра моделі NHT-TTX з CSM Instruments при температурі 295 К. У процесі наноіндентування випробувальне навантаження F_1 на индентор змінювали в діапазоні 0 - 100 мН зі швидкістю 0.05 мH/с за лінійним законом. Одночасно до індентора прикладали гармонічно змінну силу F_2 амплітудою 1 мН і частотою 20 Гц. У результаті зміна в часі результуючого навантаження на індентор описується виразом:



Рис. 1. Залежності модуля Юнга (*a*), твердості (б) кристалів $Cu_6PS_5Br(I)$ від глибини занурення індентора. 1- Cu_6PS_5I (ГТР), 2- Cu_6PS_5I (Б-С), 3- Cu_6PS_5Br (ГТР).

$$F = \frac{dF}{dt} \cdot t + F_0 \cdot \sin(\omega t) \tag{1}$$

де $\frac{dF}{dt}$ =0.05 мH/с; ω =2 πf ; F_0 = 1 мH; f = 20 Гц.

Вимірювання мікротвердості тонких плівок на основі сполуки Cu₆PS₅I проводили з допомогою мікротвердоміра ПМТ-3 при кімнатній температурі.

Результати та їх обговорення

На рис. 1. (а, б) наведені залежності модуля Юнга E (indentation modulus) та твердості H (indentation hardness) кристалів Cu₆PS₅Br(I) у широкому інтервалі змін глибини (displacement) занурення індентора. При наноіндентуванні виміряні числові значення E і H характеризують локальні механічні параметри зразка, які будуть залежати від величини області наноконтакту. Із рис. 1.а,б видно, що



Рис. 2. (*a*) - "P-h" – діаграми кристалів при навантаженні силою 100 мН протягом 10с, (*б*)-лінійна апроксимація початкової ділянки "P-h" діаграми.

найбільш значні зміни механічних параметрів досліджених кристалів проходять в інтервалі *h*=20 нм-150 нм.

При h > 150 нм E і H монотонно зменшуються. При зміні сили навантаження на індентор за формулою (1) у процесі неперервного індентування розмір області

наноконтакту *R* змінюється від атомного до мікроскопічного. Внаслідок цього проходить деформування кристалів на різних структурних рівнях.

Ефекти зміни механічних характеристик кристалів при зміні h (рис. 1), отже і зміні R, відображають розмірні ефекти у досліджених матеріалах [6]. Відомо, що при зменшенні області наноконтакту нижче 100 нм у твердих тілах відбувається зростання Е і Н, а також наближення співвідношення б/Е до теоретичної межі міцності ідеальної кристалічної гратки $(\sigma/E \approx 0.1),$ б — механічна напруга [5]. З рис 1.а, б видно що при $h \le 120$ нм спостерігається зростання Е і Н кристалів, а на залежності H(h) присутній максимум нанотвердості. Вказані особливості пов'язані з утворенням різних деформаційних зон у приконтактній області, міграцією структурних дефектів і, як наслідок, зміни механізмів деформування кристалу по мірі заглиблення індентора. Зокрема, під гострим індентором в досліджуваних матеріалах виникають такі області деформації, як: гідростатична зона, градієнтна зона, пружнопластична зона, пружна зона [7]. При зростанні сили Р навантаження на індентор та його заглиблення ці зони поширюються глубину досліджуваного зразка, їх В об'єми зростають. Вклад окремих механізмів у загальний процес формування відбитка змінюється, що призводить до зміни параметрів E і H.

На рис 2.а наведені "Р-h" діаграми наноіндентування кристалів Cu₆PS₅Br(I) при прикладанні максимального навантаження Р_т на індентор протягом 10с. За максимальними значеннями глибини відбитків h_{max} та величиною dP/dh на початковому етапі розвантаження індентора із "Р-h" діаграм були визначені числові значення твердості та модуля Юнга досліджених кристалів (таблиця). Як видно з таблиці, E і H кристалу Cu₆PS₅I (ГТР) майже у 2 і 1,5 рази відповідно перевищують ці параметри для кристалу Си₆PS₅I (Б-С). Параметри E і H кристалу Cu₆PS₅I (ГТР), також є вищими від аналогічних параметрів кристалу Cu₆PS₅Br (ГТР). Відмінність параметрів E і H кристалів Cu₆PS₅I (ГТР) і (Б-С), очевидно, можна пояснити технологічним

фактором – значно меншою дефектністю (ГТР)-кристалів у порівнянні з (Б-С)-кристалами.

Зменшення механічних характеристик E і H у (ГТР) –кристалах при заміщенні І \rightarrow Вг може бути пов'язана із зменшенням іонного радіуса галогену, що при аналогічній структурі елементарної комірки збільшує її вільний об'єм. Це приводить до зменшення жорсткості кристалічної структури.

На рис. 2б наведені ділянки "*P-h*" діаграми для кристалів Cu₆PS₅Br(I) у нанообласті. З рисунка видно, що залежність P=F(h) у цій області добре апроксимується прямими лініями, що свідчить про переважання пружного механізму деформування кристалів. На початковому етапі прикладання сили (0-5 мкН) залежність P=F(h)може бути проапроксимована формулою [8],

$$P = \frac{4}{3} \cdot E_R \cdot \sqrt{rh^3} \tag{2}$$

яка (в теорії механічного контакту ідеальних пружних тіл - теорії Герца) свідчить про чисто пружний характер деформації [9]. У формулі (2) E_R – приведений модуль Юнга $1/E_R = (1 - v_s^2)/E_s + (1 - v_i^2)/E_i$, r – радіус при вершині індентора, v і E коефіцієнт Пуассона та модуль Юнга досліджуваного матеріалу (s) та індентора (i). На рис.3 наведені ділянки "*P*-*h*" діаграм в області сил навантаження на індентор 0-5 мкН та результати їх апроксимації з допомогою формули (2). З рисунків видно, що у даній області P залежність P(h) добре апроксимується формулою Герца.

Можна допустити, що максимальна величина h, для якої виконується співвідношення (2) визначає товщину зони гідростатичного стиску. У багатьох кристалах у цій зоні під індентором проходять фазові переходи [10]. "Гладка" форма P=F(h) діадосліджених грам для кристалів Cu₆PS₅Br(I) свідчить про відсутність у них ФП при індентуванні з силою Р=100 мН. При $h \ge 150$ нм спостерігається зменшення Е і Н кристалів при зростанні h. Дане явище вказує на те, що основним механізмом деформування кристалів при $h \ge 150$ нм є пластична деформація, а механічна

	склад	IH, GPa	IE, GPa	IH, GPa	IE, GPa	IH, GPa	IE, GPa	IH _{max} ,	h _{max} ,
		10 s	10 s	100 s	100 s	h=250nm	h=250nm	GPa	nm
1.	Cu ₆ PS ₅ I - ГТр	3,316	69,954	3,19	73,984	4,35	79,60	7.13	95
2.	Cu ₆ PS ₅ I - Брд	2,078	32,657	1,738	27,6	2,79	61,54	5.10	45
3.	Cu ₆ PS ₅ Br ГТр	2,421	56,475	1,905	47,771	3,57	75,14	2.81	64
4.	Cu ₆ PS ₅ I - плівка	2,226	75,406	2,045	74,689	1,36	45,38	_	-

Механічні параметри кристалів Cu₆PS₅Br(I) за результатами наноіндентування



0,006

Рис. 3. "*P-h*" діаграми кристалів Cu₆PS₅I ГТР (1) і Cu₆PS₅Br ГТР (2) у нанообласті (*a*) та їх апроксимація в моделі Герца (δ , β).

напруга б перевищує межу міцності матеріалу. Механізмом формування пластичної деформації є рух існуючих та утворення в області наноконтакту нових протяжних дефектів, зокрема дислокацій. Імовірно, на початковому етапі пластичного деформування кристалів Cu₆PS₅Br(I) проходить також рух і утворення точкових дефектів. В подальшому пластична деформація має дислокаційний механізм. Зменшення твердості кристалів Си₆PS₅Br(I) при зростанні глибини відбитку до мікрометричних розмірів можна проінтерпретувати в рамках моделі деформаційного градієнта (MSG) [11-14]. Згідно моделі MSG індентування супроводжується утворенням кругових петель геометрично необхідних дислокацій (GND [11]) с векторами Бюргерса, нормальными до плоскої поверхні кристалу [13]. Утворення таких дислокацій призводить до деформаційного зміцнення кристалу.

Таблиця 1.

Згідно цієї моделі залежність H(h) повинна описуватися формулою [15]:

$$\frac{H}{H_0} = \sqrt{1 + \frac{h^*}{h}} \tag{3}$$

де H - твердість для заданої глибини відбитку h; H_0 – незалежна від h твердість, а h^* - характерна глибина відбитку.

Тоді (згідно MSG-моделі) H^2 повинна лінійно залежати від h^{-1} . Для перевірки виконання співвідношення (3) для кристалів Cu₆PS₅Br(I) експериментальні залежності H(h) були побудовані в координатах "H² – h⁻¹" (рис. 4). З рис. 4 видно, що залежність H(h) добре апроксимується формулою (3) в інтервалі $h \ge 600$ nm. Тобто в цьому інтервалі (мікрообласть) реалізується дислокаційний механізм пластичної деформації (згідно моделі MSG). В перехідній 150 нм – 600 нм (від нано- до мікро-) області, імовірно, реалізується змішаний механізм пластичної деформації. Її утво-



Рис. 4. Апроксимація розмірних ефектів (H=F(h)) у моделі градієнтних деформацій у мікрообласті.

рення відбувається як за рахунок руху точкових дефектів так і дислокацій.

Плівки Cu₆PS₅Br(I)

На рис.5 наведені залежності H і Eдля плівки Cu_{6.43}P_{1.15}S_{4.64}I_{0.83}. З рис.5 видно, що залежності H(h) і E(h) для плівки суттєво відрізняються від аналогічних залежностей для кристалів Cu₆PS₅Br(I) (рис. 1а, б). В інтервалі *h*=20нм-150нм



Рис. 5. Залежності твердості (1.) і модуля Юнга (2.) плівки $Cu_{6.43}P_{1.15}S_{4.64}I_{0.83}$ від глибини занурення індентора.

спостерігається сильне зростання параметрів *H* і *E*. В подальшому (*h*≥150 нм) ці параметри зростають менш інтенсивно. Для пояснення залежностей H(h) i E(h)можна використати модель м'якої тонкої плівки на жорсткій підкладці. У такій конфігурації пружна підкладка більше впливає на контактну жорсткість (а, отже, і на модуль Юнга), ніж на нанотвердость [8]. Під час зростання навантаження на індентор, деформаційні зони у області наноконтакту поширюються вглибину плівки і через деякий час можуть досягнути підкладки. Тоді числові значення Н і Е будуть визначатися механічними властивостями плівки і підкладки. Було показано, що у м'яких плівках на залежності H(h) можна виділити область числових значень нанотвердості, які характеризують механічні властивості плівок [16]. З рис. 5 видно, що такі значення Н знаходяться в інтервалі 150 - 250 нм. Швидке зростання параметрів *H* і *E* в інтервалі *h*=20нм-150 нм, очевидно, пов'язане з поетапним утворення деформаційних зон під індентором [7]. В інтервалі 150 - 250 нм проходить зростання величини та просування зон локальних деформацій в глибину плівки. У цій облас- $H(h) \approx const$ і виконується умова TÌ $h \le 0.25 d$, тобто виміряне значення $H \in$ параметром плівки.

На відміну від кристалів, при зростанні $h \ge 250$ нм для плівки $Cu_{6.43}P_{1.15}S_{4.64}I_{0.83}$ спостерігається зростання залежності *H*(h), що свідчить про досягання деформаційними зонами підкладки.

Отже, при *h* ≥ 250 нм пружна підкладка вносить значний вклад у жорсткість системи "плівка-підкладка" при взаємодії з індентором.

На рис. 6. наведена концентраційна зміна мікротвердості плівок на основі сполуки Cu_6PS_5BrI . З рисунка видно, що зростання вмісту міді в даному інтервалі призводить до зменшення твердості плівок майже в 2 рази. При цьому провідність вказаних плівок суттєво зростає. Як відомо, сильна іонна провідність вказаних плівок обумовлена утворенням каналів провідності внаслідок виникнення дендритних, кластерних структур міді при зростанні її



Рис. 6. Концентраційна залежність мікротвердості та електричної провідності тонких плівок на основі сполуки Cu₆PS₅BrI. На вставках показані ACM-зображення структури плівок при мінімальній та максимальній концентраціях міді.

концентрації. Вказане явище в аморфних матеріалах може бути пов'язане з наносепарацією при утворенні плівкових структур. На вкладках рис. 6 показані скани поверхні плівок з крайніми концентраціями міді. Видно, що структура плівок із меншою твердістю характеризується наявністю на її поверхні кластерних утворень. Тобто, в структурі плівки можна виділити жорсткі кластери і відносно м'яку міжкластерну область. При зануренні індентора у таку плівку відбуватиметься переважно відносний зсув кластерів, як жорстких сфер, у м'якому середовищі. Твердість плівки буде визначатися переважно жорсткістю міжкластерної області.

Висновки

Методом наноіндентування у режимі неперервно зростаючої та гармонічно модульованої сили навантаження на індентор визначені числові значення твердості та модуля Юнга монокристалів Cu₆PS₅Br(I). Виявлені розмірні ефекти, які спостерігаються у нано- та мікрообластях. Виявлена суттєва зміна механічних параметрів кристалів при переході у нанообласть. Показано, що у нанообласті деформація кристалів має переважно пружний характер і може бути проінтерпретована в теорії механічного контакту ідеальних пружних тіл - теорії Герца. Пластична деформація кристалів у мікрообласті має дислокаційний механізм. Розмірні ефекти у цій області можуть бути пояснені у рамках моделі деформаційного градієнта і обумовлені утворенням під час індентування кругових петель геометрично необхідних дислокацій с векторами Бюргерса, перпендикулярними до плоскої поверхні кристалу.

Зменшення мікротвердості плівок типу Cu₆PS₅BrI при зростанні вмісту міді обумовлене наносепарацією з утворенням електропровідних кластерів та дендритів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Студеняк І.П., Краньчец М. Процеси розупорядкування в суперіонних провідниках зі структурою аргіродита. – Ужгород: Говерла, 2007. – 208 с.
- 2. Kuhs W. F., Nitsche R., Scheunemann K. Vapour growth and lattice data of new compounds with icosahedral structure of

the type Cu_6PS_5Hal (Hal=Cl,Br,I) // Mat. Res. Bull. - 1976. - Vol.11, No9. - P. 1115-1124.

3. Студеняк И.П., Вайткус Р.А., Дьордяй В.С., Кеженис А.П., Микученис А.П., Панько В.В., Ковач Д.Ш., Стефанович В.А., Орлюкас А.С., Борец А.Н., Сливка В.Ю. Фазовые переходы в монокристаллах Cu₆PS₅I // Физ. тверд. тела. – 1986. – Т. 28, №3. – С. 2555-2557.

- Головин Ю.И. Наноиндентирование и механические свойства твердых тел в субмикрообъемах, тонких приповерхностных слоях и пленках. // ФТТ. – 2008. – Т.50, №12. – С. 2113-2142.
- 5. Головин Ю.И. Наноиндентирование и его возможности. Москва: Машиностроение, 2009, 312 с.
- Milman Yu.V., Golubenko A.A., Dub S.N. Indentation size effect in nanohardness. // Acta Materialia. – 2011.– 59. – P. 7480–7487.
- Giannakopoulos A.E., Suresh S. Determination of elastoplastic properties by instrumented sharp indentation. // Scripta mater. – 1999. – V. 40, N 10, – P. 1191-1198.
- Tsui T.Y., Pharr G.M. Substrate effects on nanoindentation mechanical property measurement of soft films on hard substrates. // J. Mater. Res. – 1999. – 14. – P. 292-301.
- Mason J. K., Lund A. C., Schuh C. A. Determining the activation energy and volume for the onset of plasticity during nanoindentation. // Physical review B 73. - 2006. – P. 054102:1-14.
- Min Lai, Xiaodong Zhang and Fengzhou Fang. Nanoindentation-induced phase transformation and structural deformation of monocrystalline germanium: a molecular dynamics simulation investigation. // Nanoscale Research Letters. – 2013. – V. 8, – P. 353:1-9.
- Ashby M. F. The deformation of plastica ly non-homogeneous materials. // Philos. Mag. – 1970. – V. 21. – P. 399–424.
- 12. Gao, H., Huang, Y., Nix, W. D., Hutchinson J. W. Mechanism Based

Стаття надійшла до редакції 15.05.2017

Strain Gradient Plasticity – I. Theory. // J. Mech. Phys. Solids – 1999. – 47. – P. 1239–1263.

- Nix W. D., Gao H., Indentation Size Effects in Crystalline Materials: A Law for Strain Gradient Plasticity, J. Mech. Phys. Solids 1998. V. 46, (N3). P. 411–425.
- 14. Matthew R. Begley and John W. Hutchinson. The mechanics of sizedependent indentation. // J. Mech. Phys. Solids. –1998. – V. 35, No. 9. – P. 2049-2068.
- 15. Zong Z., Lou J., Adewoye O. O., Elmustafa A. A., Hammad F., Soboyejo W. O. Indentation Size Effects in the Nano and Microhardness of FCC Single Crystal Metals. // Materials and Manufacturing Processes – 2007. – V. 22. – P. 228–237.
- 16. Биланич В.С., Lofaj F., Flachbart K., Csach K., Кузьма В.В., Ризак В.М. Наноиндентирование аморфных пленок системы Ge-As-Se. // Физика твердого тела – 2014. – Т. 56, вып. 6. – С. 1118-1122.
- 17. Studenyak I., Rybak S., Bendak A., Izai V., Guranich P., Kúš P., Mikula M. Structural disordering studies of Cu_6PS_5I based thin films deposited by magnetron sputtering. // EPJ Web of Conferences – 2017. – V. 133. – P. 02002:1-3.
- 18. Studenyak I.P., Bendak A.V., Izai V.Yu., Guranich P.P., Kúš P., Mikula M., Grančič B., Zahoran M., Greguš J., Vincze A., Roch T., Plecenik T. Electrical and optical parameters of Cu₆PS₅I-based thin films deposited using magnetron sputtering. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics – 2016. – V. 9, N 1. – P. 79-83.

В.В. Биланич¹, А.В. Бендак¹, В.Ю. Изай¹, К.В. Скубенич¹, В.И. Феделеш¹, F. Lofaj², И.П. Студеняк¹, В.С. Биланич¹, В.М. Ризак¹ ¹Ужгородский национальный университет, 88000, Ужгород, ул. Волошина, 54 ²Institute of Materials Research of SAS, Kosice, Slovak Republic e-mail: vvbilanych@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУПЕРИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ И ПЛЕНОК Сu₆PS₅Br(I) МЕТОДОМ МИКРО- И НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ

Исследовано изменение твердости H и модуля Юнга E монокристаллов и пленок Cu₆PS₅Br(I) в зависимости от глубины погружения индентора. Измерение H и E проводили при температуре 295 К в режиме гармоничной модуляции линейно возрастающей нагрузки на индентор. Изменения числовох значение E и H исследований монокристаллов в зависимости от глубины отпечатка в нано- и микрообластях проинтерпретированы в рамках модели деформационного градиента. Обнаружено уменьшение микротвердости пленок типа Cu₆PS₅Br(I) при росте содержания меди, которое обусловлено наносепарацией с образованием электропроводящих кластеров и дендритов.

Ключевые слова: нано- и микроиндентирование, суперионные материалы, Cu₆PS₅Br(I), дислокации, твердость, размерный эффект индентирования, модель пластичности градиента напряженности.

PACS 61.43.Fs, 62.25.+g, 68.60.Bs, 81.07.-b DOI: 10.24144/2415-8038.2017.41.58-67 V.V. Bilanych¹, A.V. Bendak¹, V.Yu. Izai¹, K.V. Skubenych¹, V.I. Fedelesh¹, F. Lofaj², I.P. Studenyak¹, V.S. Bilanych¹, V.M. Rizak¹ ¹Uzhhorod National University, 88000, Uzhhorod, Voloshin Str., 54 ²Institute of Materials Research of SAS, 04001, Kosice, Watsonova 47, Slovakia e-mail: vvbilanych@gmail.com

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF SUPERIONIC CRYSTALS AND FILMS Cu₆PS₅Br(I) BY MICRO- AND NANOINDENTATION METHOD

Purpose. The purpose of this work is the investigation of mechanical characteristics of superoinic crystals $Cu_6PS_5Br(I)$ and Cu_6PS_5I -based thin films deposited and to determine of indentation size effects.

Methods. The measurements of hardness H and Young's modulus E were performed using a CSM Instruments NHT-TTX nanohardness meter at a temperature of 293 K. The measurements of mikrohardness were performed using a PMT-3 mikrohardness meter with Vickers pyramid.

Results. The nanohardness and Young's modulus of $Cu_6PS_5Br(I)$ crystals and films were measured by nanoindentation method with harmonic modulation force. In dependences H(h) and E(h) reveal features that indicate a significant change in mechanical characteristics of crystals in the nanoregion. Obtained dependences have

been approximated in the framework of strain gradient plasticity theory. The mechanical parameters of Cu_6PS_5I films have been studied depending on the penetration depth of indenter during nanoindentationt. The effect of the influence substrate on the interaction between a film and indenter in nanocontact region is shown.

Conclusions. It is shown that deformation of $Cu_6PS_5Br(I)$ crystals in a nano-region is mostly elastic and can be interpreted in Hertz's theory. The plastic deformation of crystals in the micro-region has a dislocation mechanism. The dimensional effects are explained within the framework of strain gradient plasticity theories. Dimensional effects are due to the formation during the indentation of circular loops of geometrically necessary dislocations with Burgers vectors perpendicular to the plane surface of the crystal. The reduction in the microhardness of Cu_6PS_5I -based thin with increasing copper content is due to structure.

Keywords: nano- and micro-indentation, superionic materials, Cu₆PS₅Br(I), dislocations; hardness; indentation size effects, Stress-Gradient Plasticity Model. PACS NUMBER: 61.43.Fs, 62.25.+g, 68.60.Bs, 81.07.-b

REFERENCES

- Studenyak, I.P., Kranjchec, M. (2007), "Disordering processes in superionic conductors with a structure of argyrodite." [Protsesy rozuporiadkuvannia v superionnykh providnykakh zi strukturoiu arhirodytu.] – Goverla, Uzhhorod, 208 p.
- Kuhs, W. F., Nitsche, R., Scheunemann, K. (1976), "Vapour growth and lattice data of new compounds with icosahedral structure of the type Cu₆PS₅Hal (Hal=Cl,Br,I)." // Mat. Res. Bull., 11 (9), pp. 1115-1124.
- Studenyak, I.P., Vaitkus, R.A., Djordjay, V.S., Kezhenis, A.P., Mikuchenis, A.P., Panjko, V.V., Kovach, D.S.,Stefanovych, V.A., Orlyukas, A.S., Borets, A.N., Slivka, V.Yu. (1986), "Phase transitions in single crystals Cu₆PS₅I" [Fazovye perekhody v monocrystallakh Cu₆PS₅I] Phys. of solid state [Fizika tverdoho tela], 28 (3), pp. 2555-2557.
- Golovin, Yu.I. (2008), "Nanoindentation and mechanical properties of solids in submicrovolumes, thin near-surface layers and films." [Nanoindentirovanie i mechanicheskie svojstva tverdych tel v submikroobjomach, tonkich pripoverchnostnych slojach i pljonkach] Phys. of solid state [Fizika tverdoho tela], 50 (12), pp. 2113-2142.
- Golovin, Yu.I. (2009), "Nanoindentation and its capabilities." [Nanoindentirovanie i ego vozmozhnosti], Mech. Engineering, Moscow, 312 p.

- Milman, Yu.V., Golubenko, A.A., Dub, S.N. (2011), "Indentation size effect in nanohrdness." Acta Materialia, 59, pp. 7480–7487.
- Giannakopoulos, A.E., Suresh, S. (1999), "Determination of elastoplastic properties by instrumented sharp indentation." Scripta mater., 40 (10), pp. 1191-1198.
- Tsui, T.Y., Pharr, G.M. (1999), "Substrate effects on nanoindentation mechanical property measurement of soft films on hard substrates." J. Mater. Res., 14, pp. 292-301.
- Mason, J. K., Lund, A. C., Schuh, C. A. (2006), "Determining the activation energy and volume for the onset of plasticity during nanoindentation." Physical review B, 73, pp. 054102:1-14.
- Min Lai, Xiaodong Zhang, Fengzhou Fang. (2013), "Nanoindentation-induced phase transformation and structural deformation of monocrystalline germanium: a molecular dynamics simulation investigation." Nanoscale Research Letters, 8, pp. 353:1-9.
- Ashby, M. F. (1970), "The deformation of plastically non-homogeneous materials." Philos. Mag., 21, pp. 399– 424.
- Gao, H., Huang, Y., Nix, W. D., Hutchinson J. W. (1999), "Mechanism Based Strain Gradient Plasticity – I. Theory." J. Mech. Phys. Solids, 47, pp. 1239–1263.
- 13. Nix, W. D., Gao, H. (1998), "Indentation Size Effects in Crystalline Materials: A

Law for Strain Gradient Plasticity," J. Mech. Phys. Solids, 46 (3), pp. 411–425.

- Matthew, R. Begley, John, W. Hutchinson. (1998), "The mechanics of size-dependent indentation." J. Mech. Phys. Solids., 35 (9), pp. 2049-2068.
- 15. Zong, Z., Lou, J., Adewoye, O. O., Elmustafa. A. А., Hammad. F.. Soboyejo, W. O. (2007), "Indentation Size Effects in the Nano and Microhardness of FCC Single Crystal Metals." Materials and Manufacturing Processes, 22, pp. 228–237.
- Bilanych, V.S., Lofaj, F., Flachbart, K., Csach, K., Kuzma, V.V., Rizak, V.M. (2014), "Nanoindentation of amorphous films of the Ge-As-Se system." [Nanoindentirovanije amorfnych plienok sistemy Ge-As-Se] Phys. of solid state

[Fizika tverdoho tela], 56 (6), pp. 1118-1122.

- Ihor Studenyak, Stefan Rybak, Andrii Bendak, Vitalii Izai, Pavlo Guranich, Peter Kúš, Marian Mikula. (2017), "Structural disordering studies of Cu₆PS₅Ibased thin films deposited by magnetron sputtering." EPJ Web of Conferences, 133, pp. 02002:1-3.
- Studenyak, I.P., Bendak, A.V., Izai, V.Yu., Guranich, P.P., Kúš, P., Mikula, M., Grančič, B., Zahoran, M., Greguš, J., Vincze, A., Roch, T., Plecenik, T. (2016), "Electrical and optical parameters of Cu₆PS₅I-based thin films deposited using magnetron sputtering." Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 19 (1), pp. 79-83.

© Ужгородський національний університет